



Transistor MOSFET Canal-N / 200 V / 18 A / 125 W / TO-220AB / Conmutación de Alta Velocidad

SKU: IRF-640 Categoría: Misceláneo

\$45.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transistor MOSFET de canal N diseñado para aplicaciones de conmutación de alta velocidad y control de potencia en equipos electrónicos industriales. Soporta tensiones de operación de hasta 200 V con capacidad de corriente continua de 18 A, permitiendo su uso en fuentes de alimentación conmutadas, inversores y controladores de motores. La disipación máxima de potencia de 125 W garantiza estabilidad térmica en condiciones de carga elevada. El encapsulado TO-220AB facilita la instalación mecánica y la conexión a disipadores de calor convencionales, optimizando la gestión térmica en diseños compactos.

• Tipo: MOSFET Canal N

• Voltaje drenaje-fuente (V_{DS}): 200 V

• Corriente continua de drenaje (I_D): 18 A

• Disipación de potencia máxima (P_D): 125 W

• Encapsulado: TO-220AB

• Aplicación: Conmutación de alta velocidad

Desempeño Eléctrico

Voltaje drenaje-fuente: 200 V

Corriente de drenaje: 18 A

Disipación de potencia: 125 W

Físicas y Térmicas

Encapsulado: TO-220AB

Montaje: Through-hole con orificio

Compatible con disipadores estándar

Contenido del Paquete

1 x Transistor MOSFET IRF640

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación de alta velocidad para circuitos de potencia eficientes
Característica 2	Disipación térmica de 125 W para aplicaciones de alta carga
Característica 3	Encapsulado TO-220AB compatible con disipadores estándar
Característica 4	Operación confiable en rangos de 200 V para equipos industriales
Característica 5	Baja resistencia de canal para reducción de pérdidas energéticas
Característica 6	Control de carga de 18 A en fuentes de alimentación conmutadas